

УТВЕРЖДАЮ

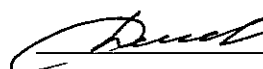
Командир в/ч 21055


С. М. Алфимов

«27» 06 2006 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
по научной работе
ОАО «ЦКБ «Дейтон»


Р. В. Данилов


«1» 06 2006 г.

Извещение АЕЯР.0012 - 2006

об изменении технических условий АЕЯР.431260.165 ТУ

СОГЛАСОВАНО


ВРИО начальника 4399 ВП МО РФ


В. Г. Сницар

«18» 05 2006 г.

Главный конструктор ИМС

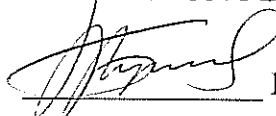
НПК «Технологический центр» МИЭТ


А. Н. Денисов

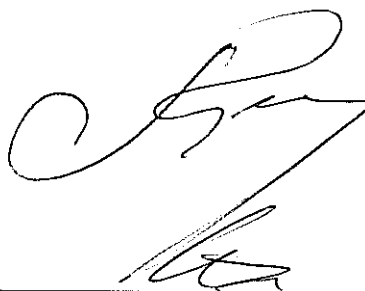
«15» 05 2006 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник 5571 ВП МО РФ


В. В. Бушуев

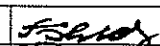
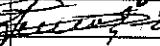
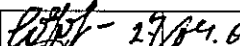
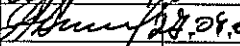
«26» 05 2006 г.



Иniv. № подлин.	Подпись и дата
Взаим. инв. №	Подпись и дата
Инв. № дубл.	Подпись и дата

НПК «ТЦ» МИЭТ	ОГК	Извещение		Обозначение		
		АЕЯР. 0012 - 2006		АЕЯР.431260.165 ТУ		
Дата выпуска		Срок изменения			Лист	Листов
						9
Причина		Введение карты заказа, корректировка документации			Код	
Указание о заделе		Не отражается				
Указание о внедрении		Внедрить с момента выпуска извещения				
Применяемость		АЕЯР.431260.165 ТУ				
Разослать		Согласно абонентскому учету				
Приложение						
Изм.	Содержание изменения					
6						

об:  5.05.06

Изм. № подлинн.	Подпись и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
<p><u>Лист 5</u> Аннулировать</p> <p><u>Лист 6</u> Заменить</p> <p><u>Лист 7</u> Заменить</p> <p><u>Лист 8</u> Заменить</p> <p><u>Лист 10</u> Заменить</p> <p><u>Лист 21</u> Заменить</p> <p><u>Лист 22</u> Заменить</p> <p><u>Лист 23</u> Заменить</p> <p><u>Лист 26</u> Заменить</p> <p><u>Лист 27</u> Заменить</p> <p><u>Лист 24</u> Заменить</p>				
Составил	Белов		26.04.06	Н.контроль
Проверил	Емельянов		26.04.06	Утвердил
Т. контроль				ВП
Подлинник исправил				
				Сидорина
				Денисов
				Снишар
				 - 27.04.06
				 28.04.06

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата

Таблица 1

Условное обозначение микросхемы	Основное функциональное название	Классификационные параметры в нормальных климатических условиях (буквенное обозначение, единица измерения)				Обозначение комплекта конструкторской документации
		Выходное напряжение высокого уровня U _{oh} , В, не менее	Выходное напряжение низкого уровня U _{ol} , В, не более	Среднее время задержки на вентиль, (измеряется в цепочке вентиляей), t _D , нс	Максимальная частота срабатывания триггера D-типа в счетном режиме, f _{cmax} , МГц	
H5503XM2	Базовый матричный кристалл (БМК)	4,0	0,4	2,0	50	ГAVЛ.431260.019

Продолжение таблицы 1

Условное обозначение микросхемы	Обозначение электрической схемы	Обозначение габаритного чертежа	Условное обозначение корпуса	Обозначение описания образцов внешнего вида	Количество вентиляей в БМК (количество элементов)	Код ОКП
H5503XM2	ГAVЛ.431260.019 Э1	У80.073.209 ГЧ	H14.42-1В	БКО.347.273 Д2	1416 (6784)	

Примечание: Классификационные параметры приведены для базовой тестовой микросхемы H5503XM2-000

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

Таблица 1а

Условное обозначение микросхемы	Основное функциональное назначение	Обозначение карты заказа	Обозначение комплекта конструкторской документации	Обозначение схемы электрической
H5503XM2-000	Тестовая ИС	ГAVЛ.431260.043 Д	ГAVЛ.431260.043	ГAVЛ.431260.043 Э3
H5503XM2-111	Схема управления буферами	ЮШКР.431262.017 Д	ГAVЛ.431260.019	ЮШКР.431262.017 Э1-③
H5503XM2-291	Устройство сопряжения	ЮШКР.430103.277 Д	ГAVЛ.431260.019	ЮШКР.430103.277 Э1-⑥

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №	Изн. № дубл.	Подпись и дата

Продолжение таблицы 1а

Условное обозначение микросхемы	Номер магнитного носителя	Количество вентиляей в схеме электрической	Испытательная группа типов	Код ОКП
H5503XM2-000	ГВЛ.431260.043 МЛ	1296	1	
H5503XM2-111	ЮШКР.431262.017 Д1	936	1	6331329375 ③
H5503XM2-291	ЮШКР.430103.277 Д1	818	1	6331347185 ⑥

2.3.4 Электрические параметры микросхем в течение срока сохраняемости должны соответствовать нормам, приведенным в таблице 2.

2.3.5 Номинальное значение напряжения питания микросхем $U_{исс}=5В$. Допустимые отклонения значения напряжения питания от номинального $\pm 10\%$.

2.3.6 Предельно допустимые и предельные электрические режимы эксплуатации в диапазоне температур окружающей среды приведены в таблице 3. Дополнительные значения предельно допустимых и предельных электрических режимов эксплуатации для конкретных микросхем приведены в карте заказа.

2.3.7 Предельное значение температуры перехода (кристалла) $150^{\circ}C$, значение теплового сопротивления корпус-кристалл не более $45^{\circ}C/Вт$.

⑥— Порядок подачи и снятия напряжения питания и входных сигналов не регламентируется.

2.3.8 Допустимое значение статического потенциала 2000В.

2.4 Требования по стойкости к воздействию механических факторов

2.4.1 Механические воздействия по ОСТ В 11 0398.

2.5 Требования по стойкости к воздействию климатических факторов

2.5.1 Климатические воздействия по ОСТ В 11 0398, в том числе:

- повышенная рабочая температура среды $+ 85^{\circ}C$;
- повышенная предельная температура среды $+ 125^{\circ}C$;
- требования к статической пыли не предъявляются.

Инв. № подлинн	Подпись и дата
	Инв. № дубл.
	Взаим. инв. №
	Подпись и дата

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	АЕЯР.431260.165 ТУ	Лист
						10

Выходная емкость подсчитывается по формуле:

$$C_{i/o} = C^{i/o} - C_{п},$$

где $C^{i/o}$ - емкость входа/выхода, измеренная на измерительном устройстве с подключением микросхемы;

$C_{п}$ - паразитная емкость измерительного устройства, измеренная без микросхемы.

3.3.4 Перед испытанием выводов на способность к пайке производится

⑤ - ускоренное старение по методу 402-1 ОСТ 11 073.013, метод 3.

Выводы микросхем должны быть облужены на всю длину выводов, включая зону крепления к корпусу.

⑤ - 3.3.5 При испытании на теплостойкость при пайке испытанию подвергаются 12 выводов одновременно с одной (любой) стороны.

3.3.6 При испытаниях на растяжение прикладывается растягивающая сила 2,5 Н (0,25кгс). Испытанию подвергают любые 4 вывода.

3.3.7 При испытаниях микросхем по подтверждению допустимых уровней статического электричества подачу импульсов проводят на любые произвольно выбранные выводы всех последовательностей, указанных в таблице 3 (часть 7) ОСТ 11 073 013.

3.3.8 Проверка стойкости маркировки микросхем к воздействию очищающих растворителей при приемо-сдаточных испытаниях (С6 последовательность 1) производится по методу 407-1 ОСТ 11 073.013.

4 Транспортирование и хранение

4.1 Транспортирование и хранение микросхем - по ОСТ В 11 0398.

Иniv. № подлин	Подпись и дата	Взам. инв. №	Иniv. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата

9 Перечень прилагаемых документов

9.1 Габаритный чертеж	У80.073.209 ГЧ.
9.2 Схема электрическая структурная	ГАВЛ.431260.019 Э1
	ЮШКР.431262.017 Э1—③
	ЮШКР.430103.277 Э1—⑥
9.3 Описание образцов внешнего вида	БКО.347.273 Д2
9.4 Карты заказа:	ГАВЛ.431260.043 Д
	ЮШКР.431262.017 Д —③
	ЮШКР.430103.277 Д —⑥
9.5 Схемы электрические принципиальные:	ГАВЛ.431260.019 Э3
9.6 Руководство по проектированию полузаказных ИС на БМК 5503	ГАВЛ.431260.019 ТУ1

*) Документ высылается по специальному запросу потребителей.

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		Лист
					АЕЯР.431260.165 ТУ	26

10 Перечень документов, на которые даны ссылки в ТУ.

Обозначение документа, на который дана ссылка	Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, перечисления, приложения разрабатываемого документа, в котором дана ссылка
ГОСТ 18683.1-83	3.3.3.1, 3.3.3.4, 3.3.3.5
ГОСТ 18683.2 –83	3.3.3.6
ГОСТ 19480-89	1.2.1
ГОСТ 20824-81	3.2.5
ГОСТ 21930-76	2.2.10 3.3.4, 5.11, рисунок 1
ГОСТ 23088	таблица 5
ГОСТ В 20.39.404-81	2.6.1
ГОСТ В 20.39.405-84	2.2.1, 2.2.12
ГОСТ В 20.57.404	таблица 5
ГОСТ В 20.57.405	таблица 5
ОСТ 11 073.063-84	5.3
ОСТ 11 073.944-87	3.3.3.2, 3.3.3.3.
ОСТ В 11 0398-2000	Вводная часть, 1.2.1, 2, 2.4.1, 2.5.1, 2.7.2, 2.8.1, 2.9.1, 3.1, 3.1.1, 3.2, 3.2.2, 3.3, 4.1, 5.1, 7.1
ОСТ В 11 073.013-83	3.2.4, 3.2.6, 3.3.4, 3.3.7, 3.3.8, таблица 5
РД 11 0723-89	Вводная часть, 1.3.2, приложение Б
РД 11 0755-90	3.1.1

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата